СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА ДИСКРЕТНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТБ ИСО 9001-2001

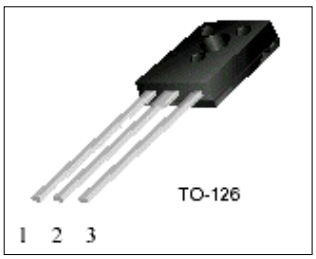
КТ940А¸В

NPN КРЕМНИЕВЫЙ ЭПИТАКСИАЛЬНО – ПЛАНАРНЫЙ ТРАНЗИСТОР

аАО.336.246ТУ/02

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ В ВЫХОДНЫХ КАСКАДАХ ВИДЕОУСИЛИТТЕЛЕЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ, УСИЛИТЕЛЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА И ДРУГИХ СХЕМАХ АППАРАТУРЫ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- Зарубежный аналог – BF459, BF458
- Изготавливается в корпусе **КТ-27 (ТО-126).**



1- эмитт 2 -колл.3 -база.

ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры	Обозначение	Единица измер.	Значение
Напряжение коллектор-база КТ940А КТ940Б КТ940В	Uкб max	В	300 250 160
Напряжение коллектор-эмиттер (Rэб≤10кОм) КТ940А КТ940Б КТ940В	Uкэ max	В	300 250 160
Напряжение эмиттер-база	Uэб max	В	5
Постоянный ток коллектора	Iк max	мА	100
Импульсный ток коллектора (tu ≤30 мкс, Q ≥10)	Iки max	мА	300
Постоянный ток базы	Iб max	мА	50
Рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом без теплоотвода	Pк max	Вт	10 1.2
Температура перехода	Tj	°С	150

Диапазон рабочих температур среды -45 ÷+85°С

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (Tокр.ср.=25°С)

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Обратный ток коллектора КТ940А КТ940Б КТ940В	Iкбо	нА	Uкб=250В, Iэ=0 Uкб=200В, Iэ=0 Uкб=100В, Iэ=0		50
Обратный ток эмиттера	Iэбо	нА	Uэб = 3 В		50
Статический коэффициент передачи тока	h_{21E}		Uкб = 10 В, Iэ= 30 мА	25	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	Uкэ(нас)	В	Iк = 30 мА, Iб = 6 мА		1.0
Емкость коллекторного перехода	Ск	пФ	Uкб=30 В,f = 10 МГц		4.2
Модуль коэфф. передачи тока	$/h_{21E}/$		Uкб = 10 В, Iэ= 15 мА f = 100 МГц	1	

220108, г. Минск, ул. Корженевского, 16, УП "Завод ТРАНЗИСТОР"
Отдел маркетинга: тел./факс (10-37517) 212-59-32
E-mail: market@transistor.com.by http://www.transistor.by